



2SC2413K (3DG2413K)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途：用于一般高频放大。

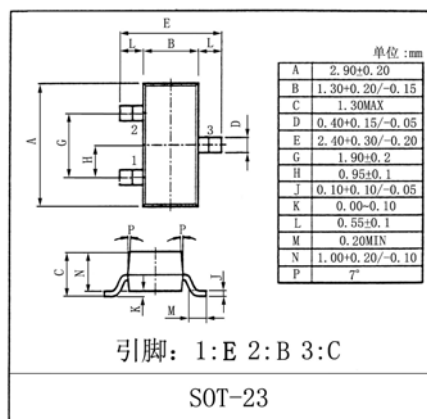
Applications: High-frequency amplifier applications.

特点：共基极输出电容小，。

Features: Low collector capacitance.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	25	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	50	mA
P_C	200	mW
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=50\mu A$ $I_E=0$	40			V
V_{CE0}	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	25			V
V_{EB0}	$I_E=50\mu A$ $I_C=0$	5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=24V$ $I_E=0$			0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=3.0V$ $I_C=0$			0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$	56		270	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.1	0.3	V
f_T	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$ $f=100MHz$	150	300		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=6.0V$ $I_E=0mA$ $f=1.0MHz$		1.3	2.2	pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	N	P	Q
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	56~120	82~180	120~270
印章 Marking	HAN	HAP	HAQ

